Wiederholung: Gasphasenstreuung

Als Resultat Energie- und Winkeländerung durch Stösse in der Gasphase ergeben sich folgende zwei Extremfälle:



Wiederholung: Potentialenergieoberflächen



Topmost Atomic Layers (Side View)

Wiederholung: Bindungsenergien

Wichtige Bindungsenergien



Wiederholung: Zeitmasstäbe

Gitterschwingungen:

$$v_0 \cong 5 \cdot 10^{12} \,\mathrm{Hz}$$

Oberflächendiffusion:

$$v_{\text{Diff}} = v_0 \cdot e^{-\frac{E_{\text{Diff}}}{k_B T_S}}$$

$$T_{S} = 300 \text{ K}$$

 $k_{B} = 1,38.10^{-23} \text{J/K}$

$$\begin{split} & \mathsf{E}_{\mathsf{Diff}} = 0,2 \; eV{=}3,2.10^{-20} \; \mathsf{J} \\ & \nu_{\mathsf{Diff}} = 2,2.10^9 \; \mathsf{Hz} \\ & \tau_{\mathsf{Diff}} = \nu_{\mathsf{Diff}}{}^{-1}{=}\; 0.5 \; \mathsf{ns} \end{split}$$

Desorption:

$$v_{\text{Des}} = v_0 \cdot e^{-\frac{E_{\text{Des}}}{k_B T_S}}$$

 $E_{Des} = 2 \text{ eV} = 3,2.10^{-19} \text{ J}$ $v_{Des} = 1,2.10^{-21} \text{ Hz(!)}$ $\tau_{Des} = v_{Des}^{-1} = 10^{13} \text{ a}$ Wiederholung: Kondensationsregimes

- Komplette Kondensation:

 Jedes auftreffende Teilchen bleibt an der Oberfläche, da die Desorptions-Frequenz extrem gering ist.
 Voraussetzung: T_s <
- Inkomplette Kondensation:
 Teilchen können desorbieren, es stellt sich ein Adsorptions/Desorptions-Gleichgewicht ein (dazu später mehr).
 Voraussetzung: T_s >

Elementarprozesse: Nukleation



Nukleationsfrequenz:

$$v_{\text{Nucl}} = v_0 \cdot e^{-\frac{\Delta G}{k_B T_S}}$$

Was ist ΔG ?

Nukleation: Mehrteilchenaggregate

2D-Aggregate - Hexagonale Koordination



Teilchen im Aggregat Teilchen im Aggregat

Nukleation: Vieltelchenaggregate-Kontinuum

Tröpfchenmodell: Grundlagen

Phasenübergang Dampf (D)/Fest (K):

 $\Delta G = G_{K}-G_{D} < 0 => Festkörper stabil$ $\Delta G = \Delta G(\sigma, p, T_{S}, r) = \Delta g_{O}(\sigma, r) + \Delta g_{V}(p, T_{S}, r)$

- r = Tröpfchenradius
- p = Druck über dem Substrat (Größer als GG-Dampfdruck)
- $T_s = Substrattemperatur$
- σ = Oberflächenenergie des Beschichtungsmaterials



$$\Delta G = \sigma r^2 + \Delta G_v(p,T_s)r^3$$

Thermodynamische Interpretation von ΔG

Bei der Nukleation handelt es sich vom thermodynamischen Standpunkt her um einen

- Isothermen
- Isobaren

Prozess, da er bei konstanter Substrattemperatur, T_s, und konstantem Übersättigungsdampfdruck, p, abläuft. Das thermodynamische Potential zur Beschreibung solcher Prozesse ist die Gibbs'sche freie Enthalpie, G



Thermodynamik: Berechnung von ΔG_V Der Volumsanteil, ΔG_V , von ΔG kann berechnet werden



$$G = U - TS + pV$$

$$d'Q = dU - d'A = dU + pdV$$

$$\Delta S = d'Q/T_{S}$$

$$\Delta G = G_{K} - G_{D} < 0$$

$$\Delta G = U_{K} - U_{D} + p^{*}v_{K} - pv_{D} - T_{S}(S_{K} - S_{D}) = p^{*}v_{D}$$

$$= \Delta U + p^{*}v_{K} - p^{*}v_{D}^{*} - T_{S} \Delta S$$

$$\Delta S = \frac{1}{T_{S}} \left(\Delta U + p^{*}v_{K} - p^{*}v_{D}^{*} + \int_{v_{D}}^{v^{*}} pdV \right)$$

$$\Delta G = -\int_{v_{D}}^{v^{*}} pdV = -RT_{S} \int_{v_{D}}^{v^{*}} \frac{dV}{V} = -RT \ln \frac{v^{*}}{v_{D}} = -RT \ln \frac{p}{p^{*}}$$

$$\Delta G_{V} = \frac{\Delta G}{V} = \frac{RT}{N_{L}V_{Atom}} \ln \frac{R_{des}}{R} = \frac{k_{B}T_{S}}{V_{Atom}} \ln \frac{R_{des}}{R}$$

Interpretation von ΔG



$$\Delta G_{V}(p,T_{S}) = -\frac{k_{B}T_{S}}{V_{Atom}} ln\left(\frac{p}{p^{*}}\right) = \frac{k_{B}T_{S}}{V_{Atom}} ln\left(\frac{R_{Des}}{R}\right)$$

Keimbildung: Der isolierte Keim

Annahmen:

- Nur ein Aggregat vorhanden
- Adsorptions/Desorptions-Gleichgewicht

Was ist "Adsorptions/Desorptions-GG" ?

Die Anzahl der Einzelatome (oder "Monomere") an der Substratoberfläche ist durch Desorptionsprozesse limitiert und bleibt im mittel konstant. Adsorptions/Desorptions-Gleichgewicht

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{n}_1}{\mathrm{d}\mathbf{t}} = \mathbf{R} - \mathbf{v}_0 \cdot \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{e}^{-\frac{\mathbf{E}_{\mathrm{Des}}}{\mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T}_{\mathrm{S}}}} = \mathbf{0}$$



- $n_1 = Monomerzahl [m^{-2}]$
- R = Beschichtungsrate [m⁻²s⁻¹]
- v_0 = Phononenfrequenz [s⁻¹]

Isolierter Keim: Tröpfchenmodell

Modellannahmen:

Adsorptions/Desorptions-GG:

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = 0 = \mathbf{R} - n_1 \mathbf{v}_0 \exp\left(-\frac{\mathbf{E}_{\mathrm{Des}}}{\mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T}_{\mathrm{S}}}\right)$$
$$n_1 = \mathbf{R} \mathbf{v}_0^{-1} \exp\left(\frac{\mathbf{E}_{\mathrm{Des}}}{\mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T}_{\mathrm{S}}}\right)$$

Zufuhr von Monomeren zum kritischen Keim:

Oberflächendiffusion aus Einfangzone der Fläche $2\pi r^*a$



Anzahl von Tröpfchen des Radius r:

$$\mathbf{n}(\mathbf{r}) = \mathbf{n}_{1} \exp\left(-\frac{\Delta \mathbf{G}(\mathbf{r})}{\mathbf{k}_{\mathrm{B}} \mathbf{T}_{\mathrm{S}}}\right)$$

Nukleationsrate kritischer Keime (Radius r*):

$$I[m^{-2}s^{-1}] = U * a \cdot n_1 \cdot v_0 \cdot \exp\left(-\frac{E_{\text{Diff}}}{k_B T_S}\right) \cdot n_1 \exp\left(-\frac{\Delta G *}{k_B T_S}\right)$$

Berücksichtigung des Adsorptions/Desorptions-Gleichgewichtes:

$$\begin{split} I[m^{-2}s^{-1}] &= U^* \cdot a \cdot n_1 \cdot R \cdot \exp\left(\frac{E_{Des} - E_{Diff} - \Delta G^*}{k_B \cdot T_S}\right) \\ &= U^* \cdot a \cdot \nu_0^{-1} \cdot R^2 \cdot \exp\left(\frac{2 \cdot E_{Des} - E_{Diff} - \Delta G^*}{k_B \cdot T_S}\right) \end{split}$$

Teilchenmodell: Massenwirkungsgesetz (MWG)

Stöchiometrische Reaktion:

 $aA + bB \underset{v_2}{\longleftrightarrow} cC + dD \qquad v_1 = k_1 c_A \cdot \ldots \cdot c_A c_B \cdot \ldots \cdot c_B$ $\underbrace{k_1}_{k_2} = K_c = \frac{c_C^c c_D^d}{c_A^a c_B^b}$ $v_2 = k_2 c_C \cdot \ldots \cdot c_C c_D \cdot \ldots \cdot c_D$



 K_{C} hängt mit der bei der Reaktion freiwerdenden bzw. verbrauchten Energie ΔE zusammen:

$$\Delta E = -k_{\rm B}T\ln K_{\rm c}$$

Massenwirkungsgesetz und Teilchenmodell

i Einzelteilchen bilden i-Teilchenaggregat:

$$c_1 \equiv n_1 / N_0 = i \cdot 1$$

$$c_i \equiv n_i / N_0 = 1$$

$$\frac{n_{i}}{N_{0}} / \left(\frac{n_{1}}{N_{0}}\right)^{i} = K_{c} = \exp\left[-\frac{\Delta E}{k_{B}T_{S}}\right] = \exp\left[\frac{E_{i}}{k_{B}T_{S}}\right]$$

 N_0 = Anzahl verfügbarer Adsorptionsplätze E_i = $-\Delta E$ = Energiegewinn bei der Bildung eines i-Teilchen Aggregates

Isolierter Keim: Teilchenmodell

Modellannahmen:

Adsorptions/Desorptions-GG

Zufuhr von Monomeren zum kritischen Keim:

Oberflächendiffusion aus Einfangzone der Fläche U_ia



Gültigkeit des MWG für die Bildung eines i-Aggregates:

i Monomere 1 i-Aggregat

$$\left(\frac{\mathbf{n}_{1}}{\mathbf{N}_{0}}\right)^{-i}\left(\frac{\mathbf{n}_{i}}{\mathbf{N}_{0}}\right) = \exp\left(\frac{\mathbf{E}_{i}}{\mathbf{k}_{B}\mathbf{T}_{S}}\right)$$

Anzahl von i-Teilchen Aggregaten:

$$\mathbf{n}_{i} = \mathbf{N}_{0} \left(\frac{\mathbf{n}_{1}}{\mathbf{N}_{0}}\right)^{i} \exp\left(\frac{\mathbf{E}_{i}}{\mathbf{k}_{B} \mathbf{T}_{S}}\right)$$

Nukleationsrate von i+1-Aggregaten:

$$\mathbf{I}_{i+1}[\mathbf{m}^{-2}\mathbf{s}^{-1}] = \mathbf{n}_i \cdot \mathbf{U}_i \cdot \mathbf{a} \cdot \mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{v}_0 \cdot \exp\left(-\frac{\mathbf{E}_{\text{Diff}}}{\mathbf{k}_{\text{B}} \mathbf{T}_{\mathbf{s}}}\right)$$

Berücksichtigung des Adsorptions/Desorptions-Gleichgewichtes:

$$I_{i+1}[m^{-2}s^{-1}] = U_i \cdot a \cdot R \cdot N_0 \cdot \left(\frac{R}{\nu_0 \cdot N_0}\right) \exp\left[\frac{(i+1) \cdot E_{Des} + E_i - E_{Diff}}{k_B \cdot T_S}\right]$$

Keimbildungsraten: Interpretation

Einfache Nukleationstheorie liefert Keimbildungsraten I der Form:

$$\mathbf{I}[\mathbf{m}^{-2}\mathbf{s}^{-1}] \cong \mathbf{A} \cdot \mathbf{R}^{\mathbf{p}} \mathbf{e}^{\frac{\mathbf{E}}{\mathbf{k}_{\mathbf{B}} \mathbf{T}_{\mathbf{S}}}}$$

Tröpfchenmodell: Teilchenmodell: $E=E(\Delta G^*) =>$ eindeutig $E=E(i, E_i) =>$ mehrdeutig

Ratengleichungen

Generell-



 $\frac{\mathrm{dn}_{\mathrm{j}}}{\mathrm{dt}} = \mathrm{U}_{\mathrm{j}-1} - \mathrm{U}_{\mathrm{j}}$

- R = Depositionsrate
- $\tau_{Des} = Monomer-Wiederverdampfungszeit$
- $n_1 = Monomerdichte$
- $n_i =$ Dichte von i-Teilchen-Aggregaten
- $U_i = Monomer-Einfangraten$ von i-Teilchenaggregaten

Vereinfacht

$$\frac{dn_{1}}{dt} = R - \frac{n_{1}}{\tau_{Des}} - \frac{d(n_{x}w_{x})}{dt}$$

$$\frac{dn_{j}}{dt} = 0 \quad (2 \le j \le i)$$

$$\frac{dn_{x}}{dt} = U_{i} - U_{c} - U_{m}$$

$$n_{x} = \sum_{j=i+1}^{\infty} n_{j} = \text{Anzahl stabiler}$$

 $w_x =$ Mittlere Atomzahl in stabilen Inseln

Inseln

- $U_i =$ Inselerzeugung: Monomereinfang
- U_c = Inselverninchtung: Wachstumskoaleszenz
- $U_m =$ Inselvernichtung: Mobilitätskoaleszenz

Aggregattypen



Ratengleichungen: Lösungen



 $K = K(\alpha, \sigma_i, C_i)$ $K \cdot \eta(z) \cong 1$ für Z<10%

Inseldichten: Interpretation

Ratengleichungen liefern Inseldichten n_x der Form:

$$n_x[m^{-2}] \cong A \cdot \left(\frac{R}{v_0}\right)^p e^{\frac{E}{k_B T_S}}$$

Der Exponent p muss nicht ganzzahlig sein und ist eine Funktion der Grösse des kritischen Keimes, i.

Observable: Inseldichte n_x

Die Lösungen der Ratengleichungen erlauben eine Vorhersage bzw. Bestimmung

- der Grösse des kritischen Keimes
- des Kondensationsregimes
- des Wachstumsmodus (2d/3d)
- der Abhängigkeit von n_x von T_s
- der Abhängigkeit von n_x von R

durch Beobachtung von n_x für ausgewählte T_S und R.

Ratengleichungen: Allgemeine Lösungsform

Inkomplette Kondensation

Komplette Kondensation

$$\frac{\mathrm{d}n_1}{\mathrm{d}t} = 0 = \mathrm{R} - \frac{n_1}{\tau_{\mathrm{Des}}}$$
$$\frac{\mathrm{d}(n_x w_x)}{\mathrm{d}t} \cong 0$$

 r_{Des} Koaleszenz log t

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{n}_{1}}{\mathrm{d}\mathbf{t}} = \mathbf{R} - \frac{\mathrm{d}(\mathbf{n}_{x}\mathbf{w}_{x})}{\mathrm{d}\mathbf{t}}$$



Beispiel: Bestimmung der krit. Keimgrösse

Sn auf polykristallinem Al:



Die Variation der Beschichtungsrate R bei konstanter Substrattemperatur T_s erlaubt die Betimmung der Partikelzahl im kritischen Keim, i



Das Kondensationsregime ist am "fractional power law", d. h. p<1, zu erkennen.

Nukleationsszenarios

Heterogene Nukleation



Homogene Nukleation



Substrat Defekt T_1

Grenzen der Ratengleichungen

Die Ratengleichungen erlauben keine Aussage über

- die Form der stabilen Inseln
- die Grössenverteilung der stabilen Inseln
- den Einfluss von Defekten auf die Nukleation

da sie eine "mean field theory" sind, d. h. den Einfluss von Korrelationen in der Inselverteilung bzw. von speziellen Inselformen auf die lokale Monomerdichte vernachlässigen. **Kinetische Monte Carlo Simulation**

Kinetische Monte Carlo (KMC) Simulationen erlauben die Bestimmung

- der Form der stabilen Inseln
- der Grössenverteilung der Stabilen Inseln
- des Einflusses von Defekten auf die Nukleation

da sie einzig und allein die Elementarereignisse des Schichtwachstums (Deposition, Oberflächendiffusion, Desorption, Teilchenbindung) zur Simulation des Schichtaufbaues heranziehen.

Kinetische Monte Carlo Simulation

- Definition von Ereignistypen
- Bestimmug der relativen Ereigniswahrscheinlichkeiten ("konditionale Wahrscheinlichkeiten")
- Auswahl eines Teilchens und Durchführung des Ereignisses
- Bestimmung des Zeitintervalles zwischen den spezifischen Ereignissen
- Vorteil: Jedes gewählte Ereignis ändert das System
- **Nachteil:** Nicht alle Ereignistypen sind a priori bekannt; Algorithmus ist speicherintensiv

KMC: Prinzip I

Teilchenkonfigurationen und Ereignistypen :

$$\begin{split} E_{\text{Diff}} &= 0.4 \text{ eV} \\ E_{\text{b}} &= 0.2 \text{ eV} \\ &\boxtimes \quad v_{1} = v_{0} \exp[-(E_{\text{Diff}} / k_{\text{B}} T_{\text{S}})] \equiv 1 \\ &\boxtimes \quad v_{2} = v_{0} \exp[-(E_{\text{Diff}} + E_{\text{b}}) / k_{\text{B}} T_{\text{S}}] \equiv 0,02v_{1} \\ &\boxtimes \quad v_{3} = v_{0} \exp[-(E_{\text{Diff}} + 2E_{\text{b}}) / k_{\text{B}} T_{\text{S}}] \equiv 4.10^{-4}v_{1} \\ &\boxtimes \quad v_{5} = v_{0} \exp[-(E_{\text{Diff}} + 3E_{\text{b}}) / k_{\text{B}} T_{\text{S}}] \equiv 9.10^{-6}v_{1} \\ &\boxtimes \quad v_{5} = v_{0} \exp[-(E_{\text{Diff}} + 4E_{\text{b}}) / k_{\text{B}} T_{\text{S}}] \equiv 2.10^{-7}v_{1} \end{split}$$

KMC: Prinzip II

Konditionale Wahrscheinlichkeiten



KMC: Prinzip III

Zeitschritt:

$$\Delta t_{\text{event}} = -\left\{ R + v_0 \left(\sum_n n_n \exp\left[-\left(E_{\text{Diff}} + nE_b\right) / \left(k_B T_S\right)\right] \right) \right\}^{-1} \ln r$$

r ... Zufallszahl [0,1[n_n...Anzahl der Monomere mit n nächsten

Nachbarn

KMC – Resultate und Trends I

Variation der Substrattemperatur T_s



Variation Beschichtungsrate R



R=0.5 ML/s



1ML/s



5 MI/s



E_{Diff}=0.5 eV E_{Des}=1 eV $E_{b} = 0.5 \text{ eV}$

T_S=700 *K E_{Diff}=0.5 eV* E_{Des}=1 eV $E_{b} = 0.5 \text{ eV}$

KMC – Resultate und Trends II

Variation der Desorptionsenergie E_{Des}



Variation der lateralen Bindungsenergie E_b





0.5 eV





1.5 eV

 $T_{S}=600 \text{ K}$ R=1ML/s $E_{Diff}=0.5 \text{ eV}$ $E_{b}=0.5 \text{ eV}$

 $T_{S}=600 \text{ K}$ R=1 ML/s $E_{Diff}=0.5 \text{ eV}$ $E_{Des}=1 \text{ eV}$

KMC – Temperaturvariation



KMC – Ratenvariation



KMC – Inselgrössenverteilungen

